Оліх

Олег

Ярославович

Ч

05.06.1974

Україна

Україна

olikh@univ.kiev.ua

0673169020

Viber: +380673169020

Telegram: +380673169020

**Науковий профіль**

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506623724;

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9M07CQ0AAAAJ;

https://orcid.org/0000-0003-0633-5429;

Індекс Хірша (SCOPUS) - 7

Науковий стаж – 24 роки

Кількість публікацій - 74

Кількість публікацій у виданнях 1-го та 2-го квартилів - 13

Досвід проведення експертизи (рецензування наукових статей, експертиза дослідницьких проектів) – вкажіть тематику експертиз та роки проведення:

рецензування наукових статей за тематикою вплив дефектів на електрофізичні властивості кремнієвих структур (RadiationPhysicsandChemistry, 2018; JacobsJournalofMaterialsScience, 2017); методи характеризації напівпровідникових бар’єрних структур за допомогою вольт-амперних характеристик (JournalofAppliedPhysics, 2017; Solid-State Electronics, 2017; Physica B: CondensedMatter, 2016), ультразвукові методи неруйнівного контролю ([Ultrasonics](http://www.sciencedirect.com/science/journal/0041624X" \o "Go to Ultrasonics on ScienceDirect), 2017); рецензування звіту про виконання завершеної науково-технічної роботи щодо розроблення пристроїв функціональної електроніки (2019).

**Наукова діяльність**

Спеціальність - фізика твердого тіла

Кількість публікацій за галуззю експертизи або напрямом досліджень - 74

Ключові слова - ультразвук, кремній, дефекти, вольт-амперні характеристики, бар’єрні структури

Найвагоміші праці, опубліковані за останні 10 років (не більше 10 праць)

https://doi.org/10.1063/1.5001123

ultrasound, silicon, acousto-defect interaction, current–voltage characteristics

https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309

Silicon solar cell, SCAPS simulator, Ideality factor, Iron concentration

https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008

Dynamic ultrasonic inﬂuence, Schottky barrier, Gamma-ray effect, Silicon

https://doi.org/10.1063/1.4926420

Schottky diode, parameters extraction, current–voltage characteristics, analytical methods, numerical methods, evolutionary methods

https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027

Silicon, Solar cells, Ultrasound inﬂuence

https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001

Shottky diode, Silicon, Ultrasound inﬂuence features, Current–voltage characteristics

https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2234137

Dose rate effects, gamma-ray effects, semiconductor devices, silicon

https://doi.org/10.1063/1.4906844

Ultrasound, Acousticallyinduced modiﬁcation, Shottky diode, Silicon

https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2047655

Defects, lifetime, radiation, silicon, ultrasound

https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712

MOS structures, Si-SiO2 interface, Ultrasound treatment, γ-rays

**Освіта**

Назва вищого навчального закладу – Київський університет ім. Тараса Шевченка

Країна - Україна

Місто - Київ

Факультет - фізичний

Спеціальність - фізика твердого тіла

Номер диплома – ЛТ ВЕ№001760

Дата видачі диплома – 28.06.1996

**Досвід роботи**

Назва установи – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Підпорядкованість –Міністерство освіти та науки України

Ministry of Education and Science of Ukraine

Посада – доцент кафедри загальної фізики

ЄДРПОУ - 02070944

Дата прийому – 02.04.1998;

Дата звільнення/Досі працюю

Місто – Київ

Kyiv

Країна – Україна

Ukraine

Поштовий індекс - 01033

Вулиця, будинок - вул. Володимирська, 60

60 VolodymyrskaStreet

Робочий телефон - (044) 5213363

Науковий ступінь

Науковий ступінь – доктор фізико-математичних наук

Номер диплому - ДД №008094

Дата видачі диплома – 18.12.2018

Академічне або вчене звання - доцент кафедри загальної фізики

ДЦ №009574

16.12.2004